

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
**научного сотрудника**  
в лаборатории наногетероструктурных излучателей и фотоприемников  
**Вакансия VAC 104852**

**Тематика исследований**

Исследование и разработка технологии пост-ростовой обработки полупроводниковых АЗВ5 гетероструктур при изготовлении фотоэлектрических преобразователей лазерного и солнечного излучения.

**Трудовая деятельность**

- Разработка топологии и конструкции фотоэлектрических преобразователей.
- Составление технологического маршрута пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур при изготовлении фотоэлектрических преобразователей.
- Разработка схем комплектов фотошаблонов.
- Проведение процессов фотолитографии на полупроводниковых гетероструктурах.
- Исследование материалов и технологии формирования антиотражающих покрытий и металлических контактов фотоэлектрических преобразователей.
- Разработка составов и изготовление электролитов для электрохимического осаждения металлических покрытий.
  - Разработка технологий жидкостного химического, электрохимического и плазмохимического травления АЗВ5 гетероструктур.
- Анализ влияния параметров пост-ростовой обработки на характеристики приборов.
- Подготовка статей для публикации в ведущих мировых журналах; представление полученных результатов на российских и международных конференциях.
- Подготовка материалов для регистрации результатов интеллектуальной деятельности.
- Выполнение научных задач и подготовка отчетов по проектам фундаментальных и прикладных исследований в качестве соисполнителя.

**Требования к кандидату:**

- Стаж научной работы по специальности не менее 5 лет
- Число публикаций по теме исследования в рецензируемых журналах не менее 15 по БД Scopus.
- Число результатов интеллектуальной деятельности по теме исследования не менее 15.
- Участие с докладами в регулярных российских или международных научных конференциях не менее 3.
- Опыт разработки технологических маршрутов пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур для изготовления фотоэлектрических преобразователей.
- Опыт работы на установках пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур, в т.ч. нанесения и экспонирования фоторезистов, электрохимического осаждения металлических покрытий.
- Опыт работы с химическими реактивами, опыт разработки и анализа составов химических травителей и электролитов.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 27 228 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;

- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.